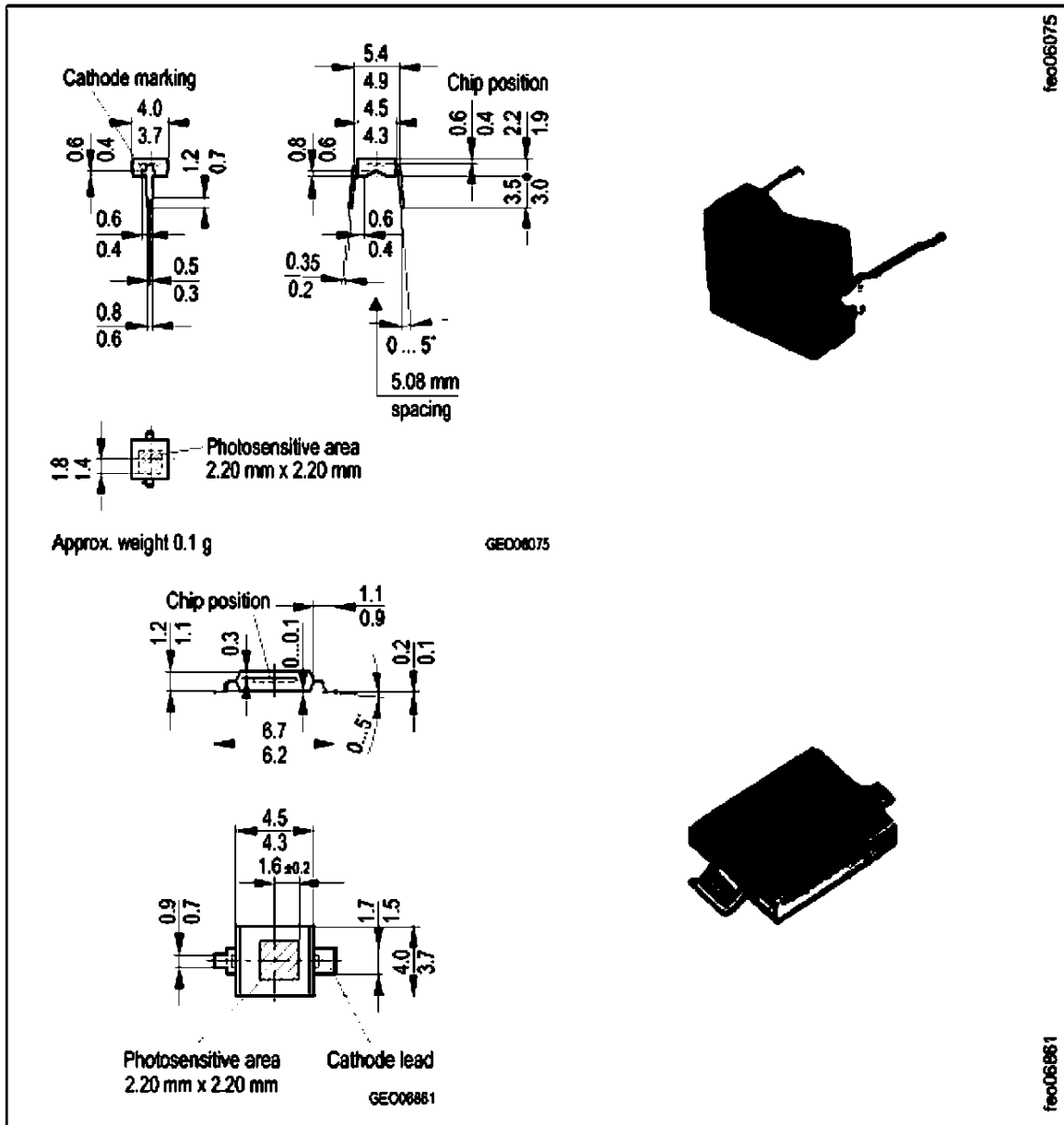


Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
NEU: in SMT
Silicon PIN Photodiode with Daylight Filter
NEW: in SMT

BP 104 F
BP 104 FS



tec06075

tec06861

BP 104 F, BP 104 FS**Wesentliche Merkmale**

- Speziell geeignet für Anwendungen bei 950 nm
- kurze Schaltzeit (typ. 20 ns)
- DIL-Plastikbauforn mit hoher Packungsdichte
- BP 104 FS: geeignet für Vapor-Phase Löten und IR-Reflow Löten

Anwendungen

- IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeräten, Videorecordern, Lichtdimmern, Gerätefernsteuerungen
- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb

Features

- Especially suitable for applications of 950 nm
- Short switching time (typ. 20 ns)
- DIL plastic package with high packing density
- BP 104 FS: suitable for vapor-phase and IR-reflow soldering

Applications

- IR remote control of hi-fi and TV sets, video tape recorders, dimmers, remote controls of various equipment
- Photointerrupters

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Gehäuse Package
BP 104 F	Q62702-P84	DIL-Gehäuse, schwarzes Epoxy-Gießharz, Kathodenkennzeichnung: Fähnchen am Anschluß DIL package, black epoxy resin Cathode marking: flag on lead
BP 104 FS	Q62702-P1646	DIL/SMT-Gehäuse, schwarzes Epoxy-Gießharz, Kathodenkennzeichnung: Langer, breiter Anschluß DIL/SMT package, black epoxy resin Cathode marking: long broad lead

Grenzwerte**Maximum Ratings**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 40 ... + 85	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	20	V
Verlustleistung, $T_A = 25\text{ °C}$	P_{tot}	150	mW

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$, $\lambda = 950\text{ nm}$)

Characteristics

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity $V_R = 5\text{ V}$, $E_e = 1\text{ mW/cm}^2$	S	34 (≥ 25)	μA
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S\text{max}}$	950	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\%$ von S_{max} Spectral range of sensitivity $S = 10\%$ of S_{max}	λ	800 ... 1100	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	A	4.84	mm^2
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche Dimensions of radiant sensitive area	$L \times B$ $L \times W$	2.20×2.20	mm x mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip front to case surface	H	0.5 0.3 (BP 104 FS)	mm
Halbwinkel Half angle	φ	± 60	Grad deg.
Dunkelstrom, $V_R = 10\text{ V}$ Dark current	I_R	2 (≤ 30)	nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity	S_λ	0.70	A/W
Quantenausbeute Quantum yield	η	0.90	Electrons Photon
Leerlaufspannung, $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ Open-circuit voltage	V_O	330 (≥ 250)	mV
Kurzschlußstrom, $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ Short-circuit current	I_{SC}	17	μA
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent $R_L = 50\ \Omega$; $V_R = 5\text{ V}$; $\lambda = 850\text{ nm}$; $I_p = 800\ \mu\text{A}$	t_r, t_f	20	ns
Durchlaßspannung, $I_F = 100\text{ mA}$, $E = 0$ Forward voltage	V_F	1.3	V
Kapazität, $V_R = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$ Capacitance	C_0	48	pF

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$, $\lambda = 950\text{ nm}$)
 Characteristics (cont'd)

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Temperaturkoeffizient von V_O Temperature coefficient of V_O	TC_V	- 2.6	mV/K
Temperaturkoeffizient von I_{sc} Temperature coefficient of I_{sc}	TC_I	0.18	%/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power $V_R = 10\text{ V}$	NEP	3.6×10^{-14}	$\frac{W}{\sqrt{Hz}}$
Nachweisgrenze, $V_R = 10\text{ V}$ Detection limit	D^*	6.1×10^{12}	$\frac{cm \cdot \sqrt{Hz}}{W}$